

## Suspended Gate Field Effect Transistor (SGFET) with polymer coating used as humidity sensor

**Publication number:** EP1191332

**Publication date:** 2002-03-27

**Inventor:** FLEISCHER MAXIMILIAN DR (DE); MEIXNER HANS PROF (DE); OSTRICK BERNHARD (DE); POHLE ROLAND DR (DE); SIMON ELFRIEDE DR (DE)

**Applicant:** SIEMENS AG (DE)

**Classification:**


**- international:** G01N27/00; G01N27/414; G01N27/00; G01N27/403; (IPC1-7): G01N27/414; G01N27/00

**- european:** G01N27/00C; G01N27/414






**Application number:** EP20010106136 20010313

**Priority number(s):** DE20001036178 20000725

**Also published as:**

 DE10036178 (A1)

**Cited documents:**

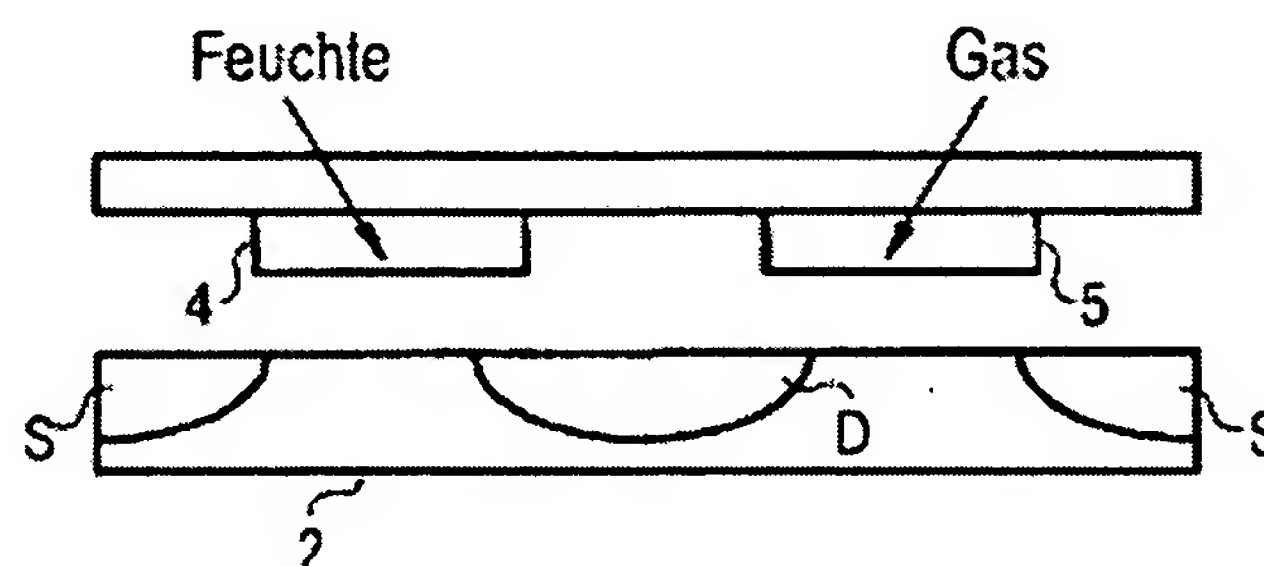
 DE2947050  
 US4730479  
 EP1103808  
 US4878015  
 DE19849932  
more >>

[Report a data error here](#)

Abstract not available for EP1191332

Abstract of corresponding document: **DE10036178**

Moisture sensor consists of a sensitive layer, and a field effect transistor using the sensitive layer as a component of its gate. An Independent claim is also included for the production of a moisture sensor comprising applying a polymer compound acting as the sensitive layer to a suspended gate FET by screen printing, spraying or pressing as the structured layer. Preferred Features: A gas-sensitive layer (5) is arranged in the FET together with a moisture sensitive layer (4). The sensor also contains a temperature measuring unit.



Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

(19)



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11)

**EP 1 191 332 A1**

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:  
27.03.2002 Patentblatt 2002/13

(51) Int Cl.7: **G01N 27/414, G01N 27/00**

(21) Anmeldenummer: **01106136.3**

(22) Anmeldetag: **13.03.2001**

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU  
MC NL PT SE TR**  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
**AL LT LV MK RO SI**

(30) Priorität: **25.07.2000 DE 10036178**

(71) Anmelder: **SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT  
80333 München (DE)**

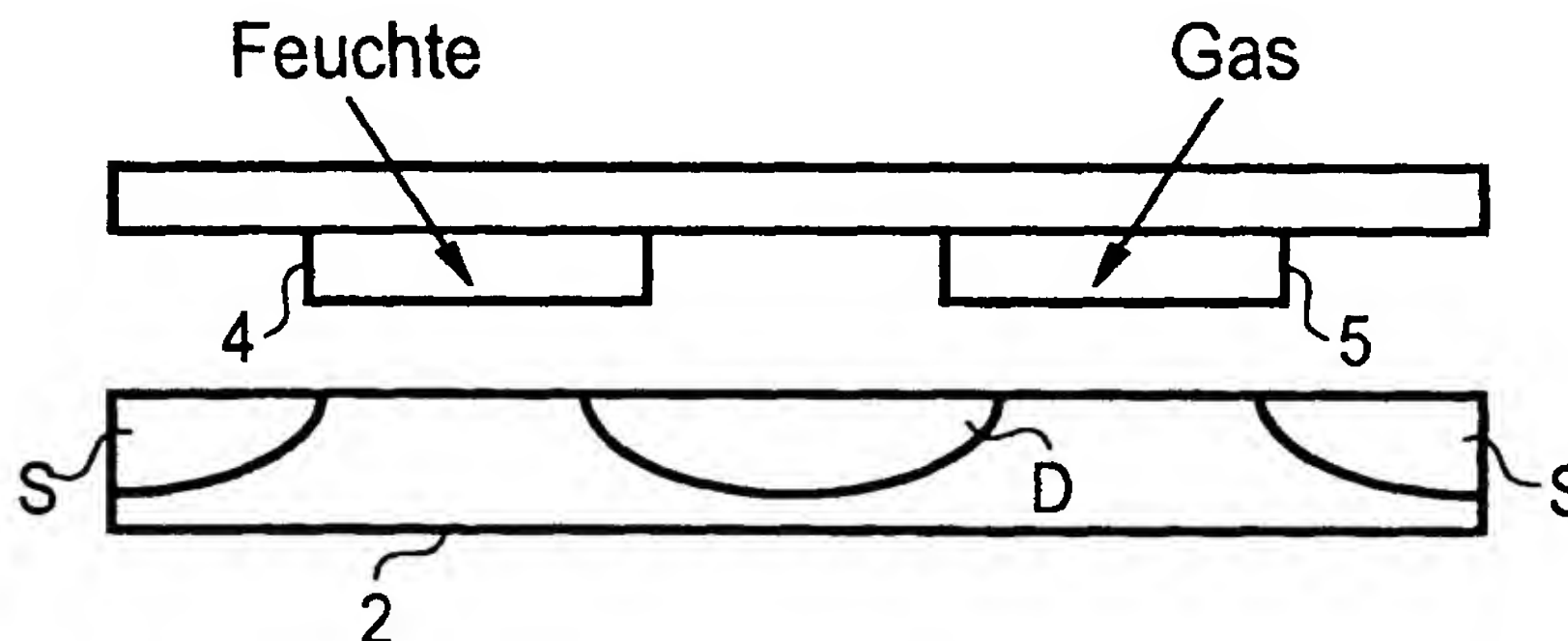
(72) Erfinder:  
• **Fleischer, Maximilian, Dr.**  
85635 Höhenkirchen (DE)  
• **Meixner, Hans, Prof.**  
85540 Haar (DE)  
• **Ostrick, Bernhard**  
81541 München (DE)  
• **Pohle, Roland, Dr.**  
85570 Herdweg (DE)  
• **Simon, Elfriede, Dr.**  
80639 München (DE)

(54) **Suspended Gate Field Effect Transistor (SGFET) mit Polymerbeschichtung als Feuchtesensor**

(57) Das Messprinzip der Austrittsleistungsänderung wird kombiniert mit der Verwendung von Polymeren, insbesondere organischen, eventuell dotierten Polymeren als sensitive Schicht. Dies ermöglicht die Herstellung von kostengünstigen Feuchte- und Gassensoren.

Die meist notwendige Berücksichtigung von Querempfindlichkeiten, insbesondere auf Feuchtigkeit, lässt sich in vorteilhafter Weise durch die Darstellung eines Suspended Gate-Feldeffekttransistors (SGFET) realisieren, der feuchtigkeitssensitive und gassensitive Schichten enthält.

### FIG 2



EP 1 191 332 A1

## Beschreibung

**[0001]** Die Erfindung betrifft einen Feuchtesensor, der nach dem Prinzip der Messung der Austrittsarbeit an der Oberfläche einer sensitiven Schicht ausgewertet wird

**[0002]** Feuchtesensoren sind neben Gassensoren in vielen Lebensbereichen verbreitete Messelemente. So spielt die Messung der Feuchtigkeit eines Gases als Kenngröße für viele Bereiche wie für die Kraftfahrzeug-Luftgüte, die Branderkennung, die Raumluftüberwachung, den Wäschetrockner oder für die Qualitätskontrolle von Nahrungsmitteln eine wesentliche Rolle. Darüber hinaus stehen viele bei Raumtemperatur durchgeführte gemssensitive Reaktionen von Sensoren für bestimmte Gase in einem direkten Zusammenhang mit dem Feuchtigkeitsgehalt. Zum einen kann der Feuchtegehalt zu veränderten Gassensitivitäten führen und zum anderen gibt es viele Gasreaktionen, die erst durch die Anwesenheit der Feuchtigkeit ermöglicht werden (Literaturstelle 1). Um diese Einschlussgröße der Feuchtigkeit zu bestimmen und gegebenenfalls die Ergebnisse der Gasdetektion zu korrigieren, ist es oft notwendig, parallel zur eigentlichen Gasdetektion den Feuchtegehalt zu messen.

**[0003]** Im Stand der Technik ist eine Reihe von kommerziellen Feuchtesensoren, die im Wesentlichen nach vier verschiedenen Prinzipien arbeiten, bekannt:

- Kapazitive Luftfeuchtemessungen können kostengünstig durchgeführt werden. Hierbei wird eine hygroskopische Polymerschicht verwendet, deren Dielektrizitätskonstante durch die Wasseraufnahme entsprechend der relativen Luftfeuchtigkeit verändert wird. Die somit veränderte Kapazität eines Dünnschichtkondensators ist direkt proportional zur relativen Feuchte (Literaturstelle 2).
- Psychrometrische Luftfeuchtemessung ist relativ kostenintensiv. Psychrometer sind Geräte, die mit einem trockenen und einem befeuchteten Temperaturfühler ausgestattet sind. Aufgrund der Verdunstung kühlt sich der Feuchtigkeitsfühler ab. Durch die Bestimmung der Temperaturdifferenz zwischen beiden Fühlern kann die Luftfeuchtigkeit ermittelt werden.
- Hygrometrische Luftfeuchtemessung ist ebenfalls aufwendig. Hygrometrische Messwertgeber sind mit einem Material ausgestattet, welches sich je nach Feuchtigkeit dehnt oder zusammenzieht. Verwendet wird organisches Material, Kunststoff oder porös gesinterte keramische Materialien wie Aluminiumoxid oder Zinkoxid.
- Eine weitere Feuchtigkeitsmessmethode ist durch ein Taupunktspiegelhygrometer gegeben. Bei diesem sehr präzise messenden Verfahren wird die Kondensation von Wasserdampf bei Taupunktun-

terschreitung ausgewertet. Die Temperatur einer verspiegelten Fläche wird soweit abgekühlt, bis diese gerade anfängt zu beschlagen. Die in diesem Moment gemessene Temperatur entspricht der Taupunkttemperatur.

**[0004]** Nachteile dieser aufgezählten Messsysteme ist, dass sie sehr kostenintensiv sind auf die jeweilige Anwendung und den Messbereich abgestimmt werden müssen bzw. für viele Anwendungen nicht geeignet sind.

**[0005]** Ein wesentliches Problem, zu dessen Lösung die Feuchtigkeitsmessung dient, ist die Querempfindlichkeit der Feuchtigkeit auf viele Gasmessverfahren. Um diesem Problem zu begegnen, gibt es Bestrebungen, die gassensitiven Materialien der Gassensoren dahingehend weiter zu entwickeln, dass sie nur geringe Sensitivität gegenüber Wasser, bei gleichzeitig hoher Sensitivität zu einem zu detektierenden Gas besitzen (Literaturstelle 7). Andererseits werden auch Untersuchungen durchgeführt, Detektionsgas und Feuchtigkeit gleichzeitig aber mit verschiedenen Schichten zu messen und mittels Mustererkennung oder Frequenzanalyse die Gasdetektion durchzuführen (Literaturstellen 3 und 4). Die Auslesung dieser Feuchtesensoren erfolgt über Oberflächenwellenfilter, durch Widerstandsmessungen oder anhand der Änderung von Dielektrizitätseigenschaften (Literaturstellen 5 und 6). Derartige Ausleseverfahren sind mit sehr hohen Kosten, im Wesentlichen für die Elektronik, verbunden bzw. erfordern häufig eine Rekalibrierung.

**[0006]** Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Feuchtesensor mit weitem Einsatzfeld, zuverlässiger und reproduzierbarer Signalauswertung und kostengünstigem Aufbau bereitzustellen. Die Lösung dieser Aufgabe geschieht durch Merkmalskombination des Anspruchs 1.

**[0007]** Die Erfindung basiert auf der Erkenntnis, dass durch die Kombination von Auslesung des Sensorsignals mittels Austrittsarbeitsänderung bei gleichzeitiger Verwendung eines Feldeffekttransistors der ein entsprechend sensitives Material als Bestandteil seines Gates aufweist, ein kostengünstiger Sensor dargestellt werden kann. Dabei ist der Einsatz von Polymeren als feuchtesensitives Material besonders vorteilhaft. Die Entwicklung eines auf organischen Verbindungen basierenden Feuchtesensors, dessen Signal mittels Austrittsarbeitsänderung ausgelesen wird, bietet den Vorteil, dass der Sensor bei Raumtemperatur betrieben werden kann. Hierbei können Messungen im Gegensatz zu bisher üblichen geheizten resistiven Sensoren bei reduziertem Heizenergiebedarf durchgeführt werden. Insbesondere durch die Einsparung der Heizenergie können kostengünstige Anwendungen erschlossen werden. Darüber hinaus ergeben sich Vorteile in Richtung einer freien Auswahl des sensitiven Materials sowie einer relativ einfachen Materialpräparation.

**[0008]** Es ist weiterhin vorteilhaft verschiedene orga-

nische Polymere einzusetzen, wie beispielsweise Polyamide, Polyvinyl, Pyrrolidon, Polyimide oder Ethylcellulose. Des weiteren können in vorteilhafterweise dotierte Polymerverbindungen als feuchtesensitive Schichten eingesetzt werden. Zur Dotierung wird insbesondere Kobaltchlorid oder Kupferchlorid verwendet.

**[0009]** Durch die Auslesung der Austrittsarbetsänderung über einen neu entwickelten Feldeffekttransistor wird ein kleiner und kostengünstiger Aufbau eines Gassensorsystems ermöglicht. Durch die Kombination von verschiedenen Schichten, feuchtesensitiven Schichten und gassensitiven Schichten, in einer Sensoranordnung können bei bekannter Temperatur Feuchteinflüsse im Vergleich der zu messenden Gasreaktion bestimmt werden. Dies ermöglicht einen direkten Signalabgleich und eine spezifische Bewertung des eigentlichen Gassensorsignals. Somit wird der Feuchtesensor in einer derartigen Sensoranordnung direkt dazu herangezogen, bei Gassensoren Querempfindlichkeiten auf Feuchtigkeit zu eliminieren.

**[0010]** Die Kostenreduzierung zur Herstellung eines derartigen Sensors resultiert im Wesentlichen aus dem verwendeten Detektionsverfahren auf der Basis der Messung der Austrittsarbetsänderung.

**[0011]** Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen können den Unteransprüchen entnommen werden.

**[0012]** Im folgenden werden anhand von schematischen Figuren nicht einschränkende Ausführungsbeispiele beschrieben.

Figur 1 zeigt den Aufbau eines gassensitiven Feldeffekttransistors,

Figur 2 zeigt eine Ausführung mit feuchte- und gassensitiver Schicht in einem Feldeffekttransistor, zugleich Gassensor,

Figur 3 zeigt die Kennlinie und die Ansprechzeiten einer Ethylcellulose- $\text{CoCl}_2$ -Schicht bei unterschiedlichen Feuchtegehalten,

Figuren 4 und 5 zeigen Kennlinien und Ansprechzeiten von bestimmten Polyamiden.

**[0013]** Figur 1 zeigt das Prinzip eines Feldeffekttransistors zur Detektion von Feuchtigkeit bzw. Gas. Die durch die Anwesenheit eines Zielgases entstehende feuchtigkeits- bzw. gasinduzierte Spannung  $V_G$  wird entsprechend zwischen Substrat 2 und sensitiver Schicht 1 abgegriffen. In Figur 1 sind die Bestandteile des Feldeffekttransistors FET, sowie in dem Substrat 2 dargestellte Source- und Drain-Bereiche gekennzeichnet. Die Kanalisolierung 3 ist in Form einer das Substrat, den Source- und dem Drain-Bereich überdeckenden Schicht ausgebildet. Die in Figur 1 dargestellte Variante eines Feldeffekttransistors weist einen Luftspalt zwi-

schen der Kanalisolierung 3 und einem sensitiven Material auf. Dies entspricht dem Prinzip eines Suspended Gate-FET. Als Grundidee liegt hier eine frei wählbare Sensorschicht vor, wobei bei Gasadsorption/Oberflächenreaktion an dieser Schicht eine reversible Änderung der Austrittsarbeit auftritt. Diese Potentialdifferenz, welche in der Größenordnung von 50 mV liegt, koppelt kapazitiv über den Luftspalt an die Kanaloberfläche und induziert Ladungen in die FET-Struktur.

**[0014]** In Figur 2 sind gleichzeitig eine feuchtesensitive 4 und eine gassensitive Schicht 5 in einer einzigen Anordnung von zwei integrierten Feldeffekttransistoren vorhanden. Die sensitiven Schichten 4, 5 sind jeweils zwischen den gegenüber liegenden Source- und Drain-Bereichen auf dem Substrat 2 positioniert. Der Abgriff von entsprechenden Sensorsignalen erfolgt analog zu Figur 1.

**[0015]** Mit dem derart vorgestellten Gassensor ist also zum einen eine kostengünstige Realisierung für die direkte Entwicklung von Feuchtesensoren für verschiedene Anwendungen möglich, wie beispielsweise Wäschetrockner, Kraftfahrzeug-Luftgüte, Klimaanlage usw.. Zum anderen können durch Kombination von gassensitiver Schicht und feuchtesensitiver Schicht gassensitive Effekte, die durch den Feuchtigkeitsgehalt beeinflusst sind, korrigiert werden.

**[0016]** Die Kombination des Messprinzips der Austrittsarbetsänderung an sensitiven Schichten und der Verwendung von organischen Materialien für die sensitive Schicht kann somit zur Bestimmung der Feuchte in Gasen herangezogen werden, wobei ein Sonderfall die direkte Verwendung dieser Information zur Eliminierung von Querempfindlichkeiten aufgrund vorhandener Feuchte bei der Gasdetektion ermöglicht. Damit ergibt sich gleichzeitig eine kostengünstige sogenannte Low-power/Lowcost-Variante eines Gassensorsystems, da Gassensoren entsprechend der Figuren 1 und 2 kostengünstig herzustellen sind. Zusätzlich können derartige Feuchtesensoren mit der Bestimmung der Gastemperatur kombiniert werden, so dass sämtliche weiteren hygroskopischen Parameter wie Taupunkt, relative Luftfeuchte, Sättigungsdampfdruck oder Partialdampfdruck ermittelbar sind.

**[0017]** Untersuchungen verschiedener Verbindungen zeigten, dass organische Polymere wie beispielsweise Polyimide, Polyamide, Ethylcellulose und dotierte Polymere für eine direkte Messung der Feuchte mittels Austrittsarbetsänderung geeignet sind.

**[0018]** Darüber hinaus konnte durch Dotierung von organischen Polymeren mit hygroskopischen Metallsalzen wie beispielsweise mit Kobaltchlorid oder Kupferchlorid eine Steigerung der Feuchtesensitivität gegenüber den undotierten Polymeren erzielt werden.

**[0019]** Figur 3 zeigt die Kennlinie und Ansprechzeiten einer mit Kobaltchlorid dotierten Ethylcellulose-Schicht bei unterschiedlichen Feuchtegehalten. Das Sensorsignal wird in Millielektronenvolt gemessen und zeigt eine annähernd lineare Abhängigkeit von der relativen



Feuchte des Messgases.

**[0020]** Die Figuren 4 und 5 zeigen Kennlinien und Ansprechzeiten von verschiedenen Polyamid-Derivaten. In Figur 4 wurde eine feuchtigkeitssensitive Schicht aus Nylon 6/6 verwendet und in Figur 5 eine aus Nylon 6/66. Das Signal der jeweiligen Sensoren steigt mit zunehmender Feuchtekonzentration an. Bei einer Änderung der relativen Feuchte von 20% auf 80% ergibt sich jeweils ein Sensorsignal von 95 mV bzw. 135 mV. Dies entspricht der feuchtigkeitsinduzierten Spannung aufgrund der Austrittsenergieänderung an der feuchtigkeits-sensitiven Schicht. Querempfindlichkeiten hinsichtlich der Messungen entsprechend Figur 4 und 5 auf andere Bestandteile eines Gasgemisches können nach wie vor auftreten.

**[0021]** Die Polymerverbindungen wie z.B. Polyvinylpyrrolidon werden mittels Siebdrucktechnik, Sprühfilm oder Tampondruck als strukturierte Schicht auf das Gate des SG-FET aufgebracht. Durch die Verwendung einer Polymer-Paste werden bestimmte Schichtstrukturen mit festgelegter Schichtdicke hergestellt die wesentlich die Sensitivität des Sensors beeinflussen. Das Polymer Polyvinylpyrrolidon hat z.B. bei einer Schichtdicke von 4.5 µm eine um 50% höhere Sensitivität als mit einer Schichtdicke von 2.5 µm. Diese Paste besteht aus dem Polymer und zwei oder mehreren Lösungsmitteln, die in einem bestimmten Verhältnis (z.B. 2 Teile Polyvinylpyrrolidon + 16 Teile Terpeneol + 1 Teil Hexan) gemischt werden um die entsprechende Viskosität zu erhalten, die wesentlich für die Schichtstruktur und Schichtdicke ist.

#### Literaturliste

#### [0022]

[1] T. Doll, J. Lechner, I. Eisele, K.-D. Schierbaum, W. Göpel: Ozone detection in the ppb range with work function sensors operating at room temperature, Sensors and Actuators B 34 (1996) 506-510

[2] M. Matsuguchi, S. Umeda, Y. Sadaoka, Y. Sakai: Characterization of polymers for a capacitive-type humidity sensor based on water sorption behaviour, Sensors and Actuators B 49 (1998) 197-185.

[3] K. Korsah, C. L. Ma, B. Dress: Harmonic frequency analysis of SAW resonator chemical sensors: application to the detection of carbon dioxide and humidity, Sensors and Actuators B 50 (1998) 110-116

[4] A. E. Hoyt, A. J. Ricco, J. W. Bartholomew, G. C. Osburn: Simultaneous measurement of CO<sub>2</sub> and humidity using a pair of SAW devices and cluster-analysis pattern recognition, in: Tagungsband Transducers '97, Chicago 1997, 1339-1342

[5] D. Rebière, C. Déjous, J. Pistré, J. F. Lipskier, R. Planade: Synthesis and evaluation of fluoropolyol isomers as saw microsensor coatings: role of humidity and temperature, Sensors and Actuators B 49 (1998) 139-145

[6] R. Buchhold, A. Nakladal, G. Gerlach, P. Neumann: Design studies on piezoresistive humidity sensors, Sensors and Actuators B 53 (1998) 1-7

[7] J. Clements, N. Boden, T. D. Gibson, R. C. Chandler, J. N. Hulbert, E. A. Ruck-Keene: Novel, self-organising materials for use in gas sensor arrays: beating the humidity problem, Sensors and Actuators B 47 (1998) 37-42

#### Patentansprüche

##### 1. Feuchtesensor bestehend aus:

- mindestens einer sensitiven Schicht 1 (deren Austrittsarbeit von der Konzentration der vorhandenen Feuchtigkeit abhängt,
- einem Feldeffekttransistor (FET) mit der mindestens einen sensitiven Schicht 1 als Bestandteil seines Gates.

##### 2. Feuchtesensor nach Anspruch 1, bei dem die sensitive Schicht 1 aus einem Polymermaterial besteht.

##### 3. Feuchtesensor nach Anspruch 2, bei dem die sensitive Schicht 1 aus einem organischen Polymer besteht wie Polyamid, Polyvinyl, Pyrrolidon, Polyimid oder Ethylcellulose.

##### 4. Feuchtesensor nach Anspruch 2 oder 3, bei dem ein Polymer mit Kobaltchlorid oder Kupferchlorid dotiert ist.

##### 5. Feuchtesensor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem im gleichen Feldeffekttransistor (FET) neben einer feuchtesensitiven Schicht 4 mindestens eine gassensitive Schicht 5 vorhanden ist, die nach dem gleichem Messprinzip auslösbar ist.

##### 6. Feuchtesensor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem zusätzlich eine Temperaturmesseinheit vorhanden ist.

##### 7. Verwendung eines Feuchtesensors entsprechend einem der Ansprüche 1 bis 6 als integraler Bestandteil eines Gassensors zur Eliminierung der Feuchtequerempfindlichkeit für das Signal des Gassensors.

##### 8. Verfahren zur Herstellung eines Feuchtesensors

entsprechend einem der Ansprüche 1-6, bei dem die als sensitive Schicht dienende Polymerverbindung mittels Siebdrucktechnik, Sprühfilm oder Tampondruck als strukturierte Schicht auf einen SG-FET (Suspended Gate FET) aufgebracht wird. 5

9. Verfahren nach Anspruch 8, bei dem die hergestellte Schichtdicke ungefähr 4,5 µm beträgt.
10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, bei dem eine beim Druck verwendete Paste aus dem Polymer und zwei oder mehreren Lösungsmitteln besteht. 10
11. Verfahren nach Anspruch 10, bei dem ein Verhältnis von 2 Teilen Polyvinylpyrrolidon, 16 Teilen Terpeneol und einem Teil Hexan vorliegt. 15

20

25

30

35

40

45

50

55

FIG 1

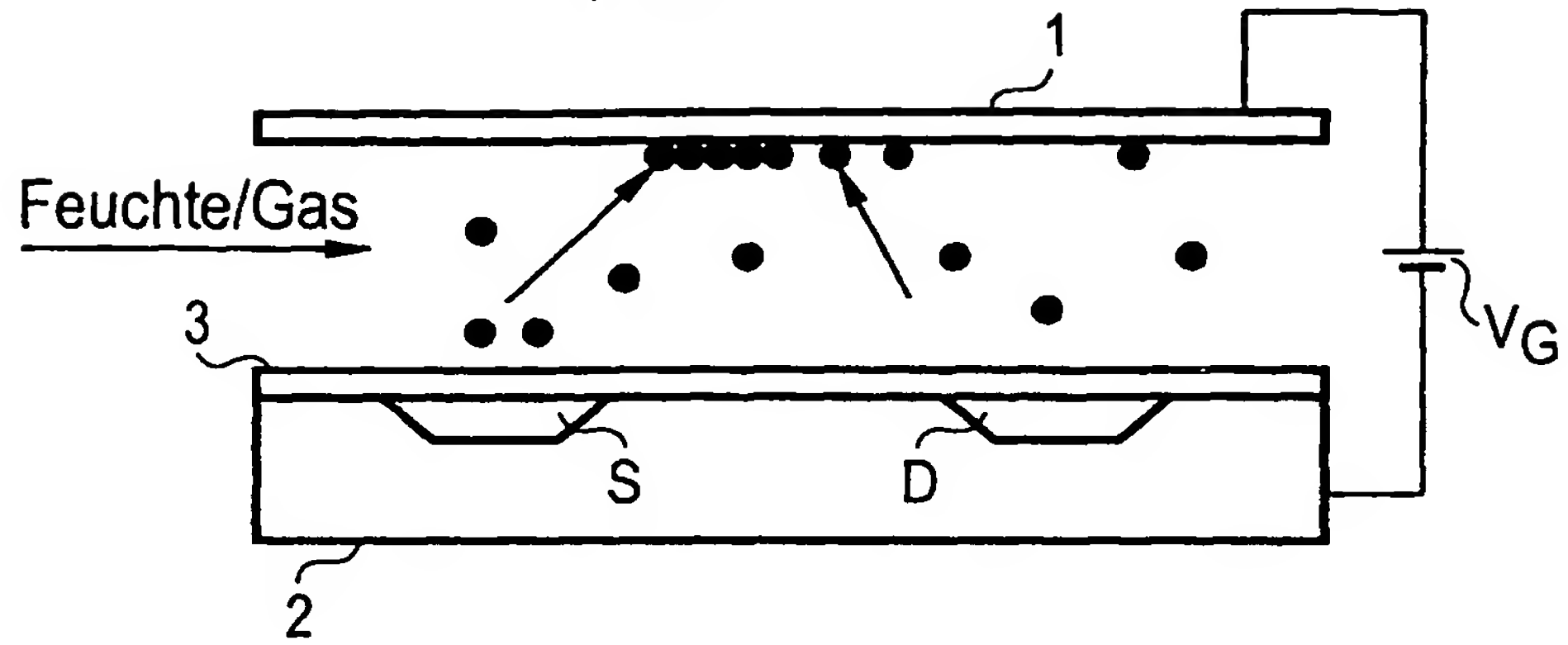
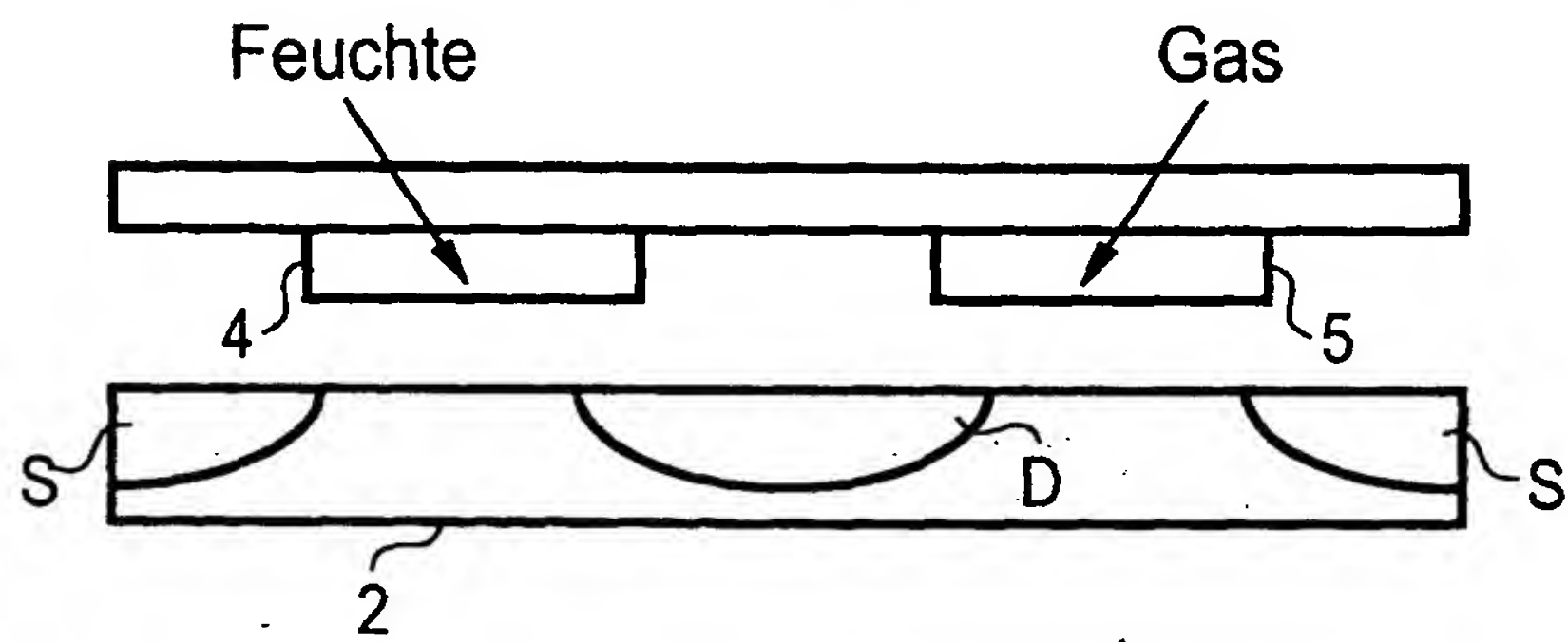
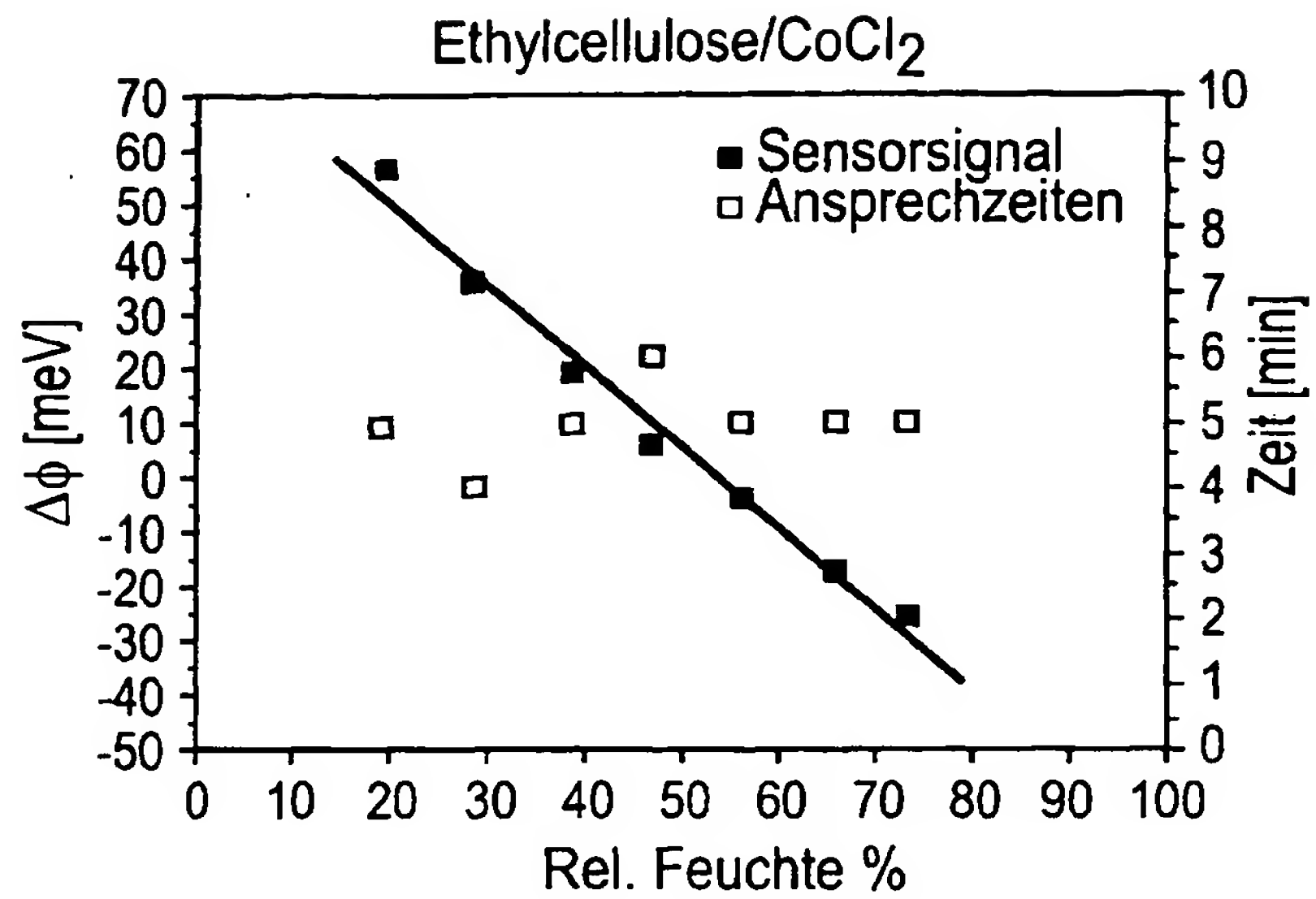


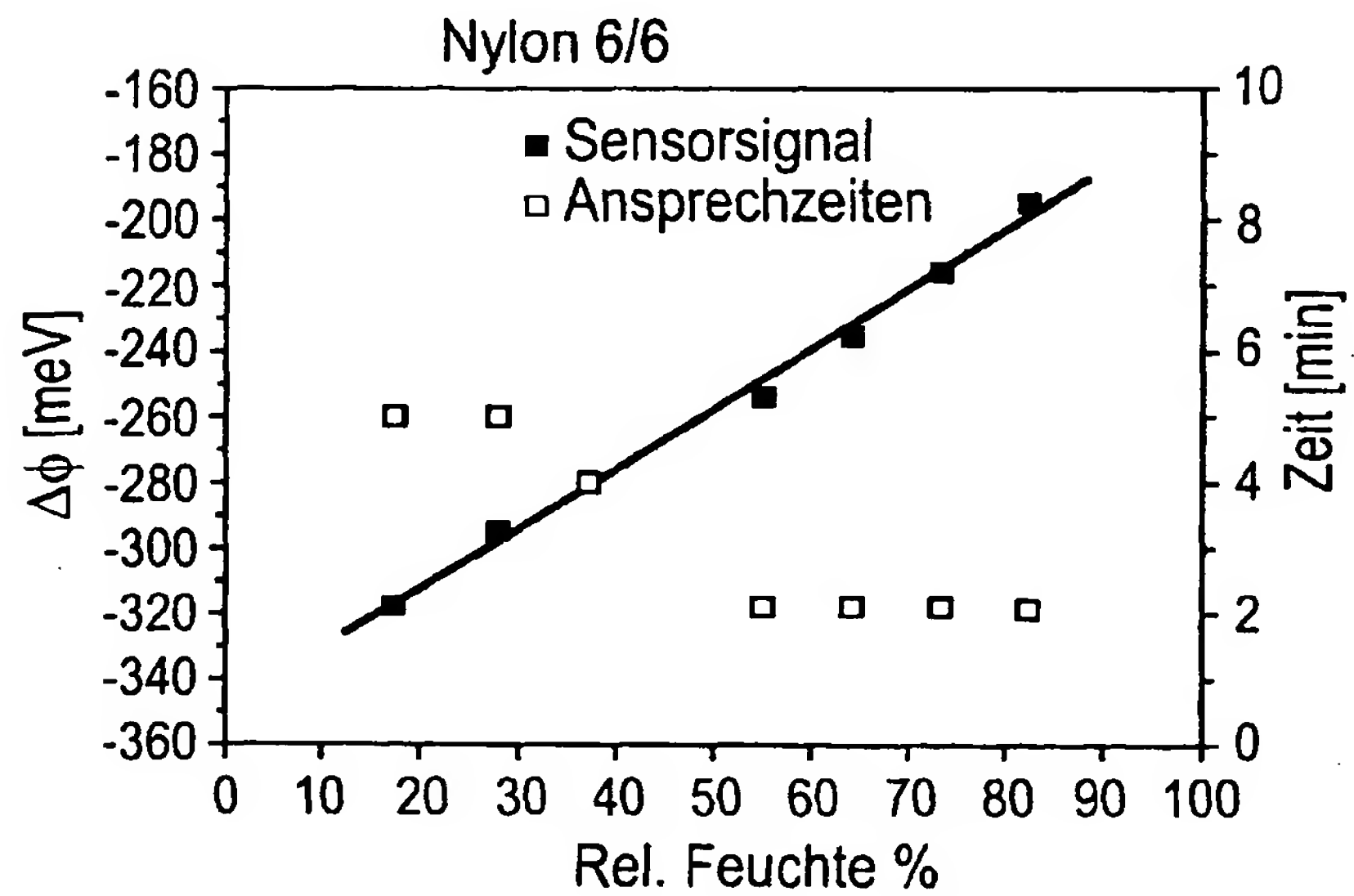
FIG 2



**FIG 3**

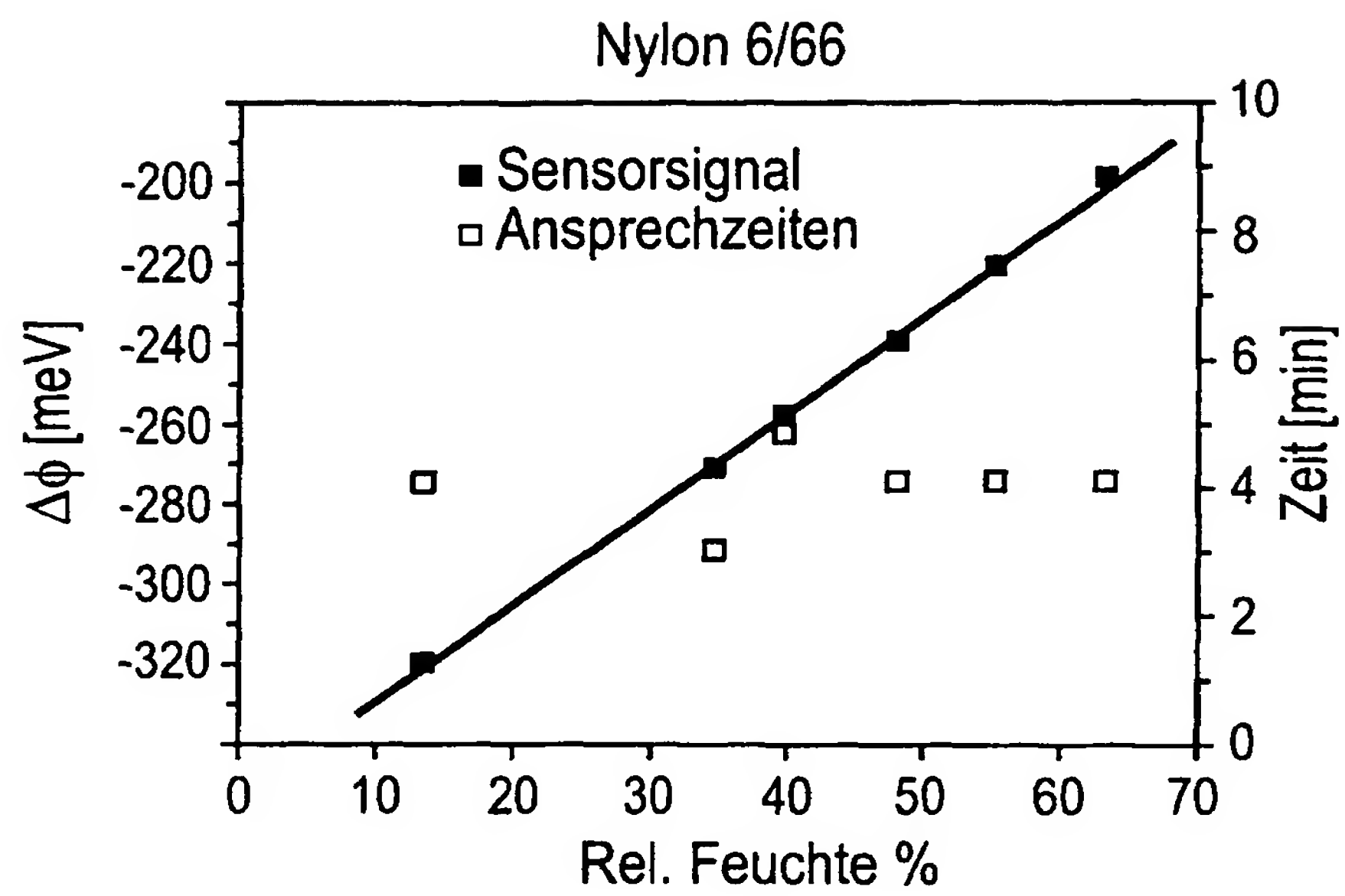


**FIG 4**





**FIG 5**





Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 01 10 6136

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
X	DE 29 47 050 A (HOEFFLINGER BERND; DOBOS KAROLY DR) 27. Mai 1981 (1981-05-27) * Seite 6, Zeile 1,2; Ansprüche 1,3,8; Abbildungen 1A,,3,,4B * * Seite 8 *	1,2,5-7	601N27/414 601N27/00
X	US 4 730 479 A (PYKE STEPHEN C ET AL) 15. März 1988 (1988-03-15) * Spalte 4, Zeile 31 - Zeile 60 * * Spalte 7, Zeile 11 - Zeile 22; Ansprüche 2-4,11,12 *	1,5-7	
E	EP 1 103 808 A (SIEMENS AG) 30. Mai 2001 (2001-05-30) * Spalte 1, Zeile 48 - Zeile 56 *	1,7	
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 006, no. 133 (P-129), 20. Juli 1982 (1982-07-20) & JP 57 056746 A (HITACHI LTD), 5. April 1982 (1982-04-05) * Zusammenfassung; Abbildungen 1-7 *	1-3	
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 001, no. 148 (E-069), 29. November 1977 (1977-11-29) & JP 52 087381 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD), 21. Juli 1977 (1977-07-21) * Zusammenfassung * & DATABASE WPI Section Ch, Week 197736 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class A14, AN 1977-63492Y * Zusammenfassung *	1-3	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7) G01N
Recherchenort <b>MÜNCHEN</b>		Abschlußdatum der Recherche <b>27. November 2001</b>	Prüfer <b>Strohmayer, B</b>
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03 82 (Pkt C03)



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 01 10 6136

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
X A	US 4 878 015 A (SCHMIDT HELMUT ET AL) 31. Oktober 1989 (1989-10-31) * Spalte 5, Zeile 57 - Spalte 6, Zeile 40; Abbildungen 1,11 * * Spalte 3, Zeile 31,60 * *, Satz 18 - Satz 52 * * Spalte 9, Zeile 62 - Spalte 10, Zeile 24 * * Spalte 10, Zeile 55 - Spalte 11, Zeile 8 *	1,2,5,7 8	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
X	DE 198 49 932 A (SIEMENS AG) 11. Mai 2000 (2000-05-11) * Spalte 3, Zeile 24 - Zeile 27 * * Spalte 4, Zeile 66 - Spalte 5, Zeile 7; Anspruch 17; Abbildungen 1,2 *	1,2,8-10	
X A	US 4 764 797 A (SHAW JOHN E A ET AL) 16. August 1988 (1988-08-16) * Spalte 2, Zeile 30 - Zeile 61; Abbildung 2B * * Spalte 4, Zeile 22 - Zeile 67; Abbildungen 6A,6B * * Spalte 5, Zeile 8 - Zeile 43 *	1-3,5-7 8,10	
X A	US 4 515 653 A (FURUBAYASHI HISATOSHI ET AL) 7. Mai 1985 (1985-05-07) * Spalte 2, Zeile 18 - Zeile 43 * * Spalte 3, Zeile 41 - Zeile 51 *	1-3 8,10	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort <b>MÜNCHEN</b>		Abschlußdatum der Recherche <b>27. November 2001</b>	Prüfer <b>Strohmayer, B</b>
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03/82 (P04.003)



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 01 10 6136

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
X	"SUSPENDED GATE FETS AS GAS SENSORS" ELECTRONIC ENGINEERING, MORGAN-GRAMPIAN LTD. LONDON, GB, Bd. 64, Nr. 787, 1. Juli 1992 (1992-07-01), Seite 10,13 XP000307786 ISSN: 0013-4902 * gesamtes Dokument, insbesondere Absatz "Organic materials" *	1-3,8	
T	EISELE I ET AL: "Low power gas detection with FET sensors" SENSORS AND ACTUATORS B, ELSEVIER SEQUOIA S.A., LAUSANNE, CH, Bd. 78, Nr. 1-3, 30. August 2001 (2001-08-30), Seiten 19-25, XP004297630 ISSN: 0925-4005 * Zusammenfassung; Abbildungen 2,3 * * Absätze "3.4. Polymers and organic films" und "4.2. Humidity" *	1	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
Recherchenort <b>MÜNCHEN</b>		Abschlußdatum der Recherche <b>27. November 2001</b>	Prüfer <b>Strohmayer, B</b>
<p><b>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</b></p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument I : aus anderen Gründen angeführtes Dokument &amp; : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

EPO FORM 1603 (3.12.92) (P04003)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT  
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 01 10 6136

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.  
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Daten des Europäischen Patentamts am  
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

27-11-2001

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 2947050	A	27-05-1981	DE 2947050 A1	27-05-1981
US 4730479	A	15-03-1988	KEINE	
EP 1103808	A	30-05-2001	EP 1103808 A2	30-05-2001
JP 57056746	A	05-04-1982	KEINE	
JP 52087381	A	21-07-1977	KEINE	
US 4878015	A	31-10-1989	DE 3526348 A1	05-02-1987
			AT 53259 T	15-06-1990
			DE 3671666 D1	05-07-1990
			WO 8700633 A1	29-01-1987
			EP 0231305 A1	12-08-1987
			JP 63500739 T	17-03-1988
DE 19849932	A	11-05-2000	DE 19849932 A1	11-05-2000
			AU 1769400 A	22-05-2000
			WO 0026656 A1	11-05-2000
US 4764797	A	16-08-1988	EP 0215546 A2	25-03-1987
			JP 62066154 A	25-03-1987
US 4515653	A	07-05-1985	JP 1615874 C	30-08-1991
			JP 2042430 B	21-09-1990
			JP 59202053 A	15-11-1984
			JP 1615875 C	30-08-1991
			JP 2042431 B	21-09-1990
			JP 59204750 A	20-11-1984
			DE 3416124 A1	31-10-1984
			GB 2138952 A ,B	31-10-1984

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82